

N型GaAs欧姆接触中各组份对比接触电阻的影响

摘要点击: 1759 全文下载: 901

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

所在位置: 1980, 1(2): 100-106

中文关键词:

英文关键词:

基金项目:

PACC代码:

EEACC代码:

作者

单位

[吴鼎芬](#)

[陈芬扣](#)

中文摘要:

用类似液相外延的设备,测定了Ga与As在450°C至550°C间在Au-Ge和Au-Ge-Ni熔体中的溶解度.发现温度升高,Ga与As的溶解度增加,但由于As的逸损,在熔体中Ga与As的比例也增大.自Au-Ge的共晶组份起,Au含量的提高和Ni的加入均使Ga和As的溶解度增加.自热力学活度角度讨论了溶解度提高的原因.测定了Au-Ge与Au-Ge-Ni(或Fe、Cr、Co)系统的比接触电阻,并结合溶解度的实验和热力学活度的计算进行了讨论.分析了各组份对欧姆接触比接触电阻的影响.

英文摘要:

您是第705379位访问者

主办单位: 中国电子学会, 中国科学院半导体研究所 单位地址: 北京市海淀区清华东路甲35号

Service Tel: 010-82304277, 82304311 Fax: 010-82305052 邮编: 100083 Email: cjs@semi.ac.cn

本系统由勤云电子有限公司设计,技术支持电话: 010-81928386, Email: et_yehu@yahoo.com.cn, 网址: <http://www.e-tiller.com>